

Описание

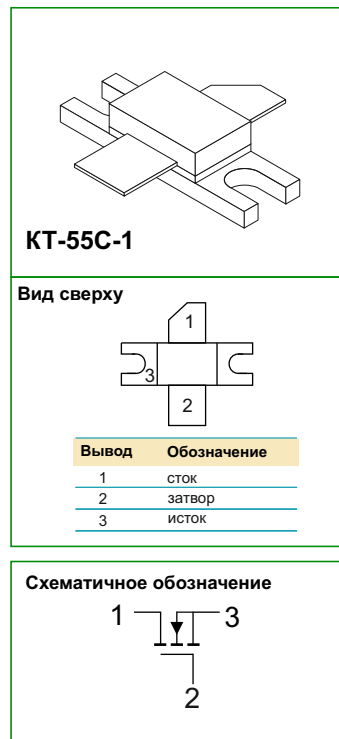
- Мощный импульсный GaN транзистор с напряжением питания 50 В
- Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-55С-1

Основное назначение

- Транзисторы предназначены для работы в усилителях мощности до 2700 МГц

Основные характеристики

- Выходная импульсная мощность $P_{\text{вых}}$ и ≥ 200 Вт
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 50$ В
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} = 13,5$ дБ (тип.)
- КПД стока $\eta_c = 55$ % (тип.)
- Длительность импульса $\tau_{\text{и}} = 300$ мкс
- Сквозность $Q = 10$



Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	I_c макс	7	А	
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си}}$ макс	150	В	1
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В	
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п}}$ макс	225	°С	
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С	

Примечание 1 - для всего диапазона рабочих температур



Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	$I_{с\text{ ост}}$	$U_{си}=150\text{ В}, U_{зи}=-8\text{ В}$	-	-	9	мА	25 ± 10
Крутизна характеристики	S	$I_{с}=4\text{ А}, U_{си}=10\text{ В}$	5,7	7,1	-	А/В	25 ± 10
Ток стока	$I_{с}$	$U_{си}=10\text{ В}, U_{зи}=2\text{ В}$	21,7	27,1	-	А	25 ± 10
Выходная импульсная мощность	$P_{\text{вых и}}$	$f=2000\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, P_{\text{вхи}}=12,6\text{ Вт}, I_{с.0}=0,1\text{ А}$	200	240	-	Вт	25 ± 15
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=2000\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, P_{\text{вых и}}=200\text{ Вт}, I_{с.0}=0,1\text{ А}$	12	13,5	-	дБ	25 ± 15
Коэффициент полезного действия стока	$\eta_{с}$	$f=2000\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, P_{\text{вых и}}=200\text{ Вт}, I_{с.0}=0,1\text{ А}$	50	55	-	%	25 ± 15

Справочные электропараметры

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения
Ток утечки затвора	$I_{з\text{ ут}}$	$U_{си}=50\text{ В}, U_{зи}=-8\text{ В}$	-	-	7	мА
Напряжение отсечки	$U_{зи\text{ отс}}$	$I_{си}=15\text{ мА}, U_{си}=10\text{ В}$	-3,7	-3	-2,3	В
Пробивное напряжение сток-исток	$U_{си\text{ проб}}$	$I_{си}=8\text{ мА}, U_{зи}=-8\text{ В}$	150	-	-	В
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	$R_{си\text{ отк}}$	$I_{с}=4\text{ А}, U_{зи}=0\text{ В}$	-	0,12	0,15	Ом
Входная емкость	$C_{11\text{ и}}$	$f=1\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, U_{зи}=-8\text{ В}$	-	29,8	35,8	пФ
Выходная емкость	$C_{22\text{ и}}$	$f=1\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, U_{зи}=-8\text{ В}$	-	17,3	20,8	пФ
Проходная емкость	$C_{12\text{ и}}$	$f=1\text{ МГц}, U_{си}=50\text{ В}, U_{зи}=-8\text{ В}$	-	1,9	2,3	пФ

Типовые зависимости электрических параметров

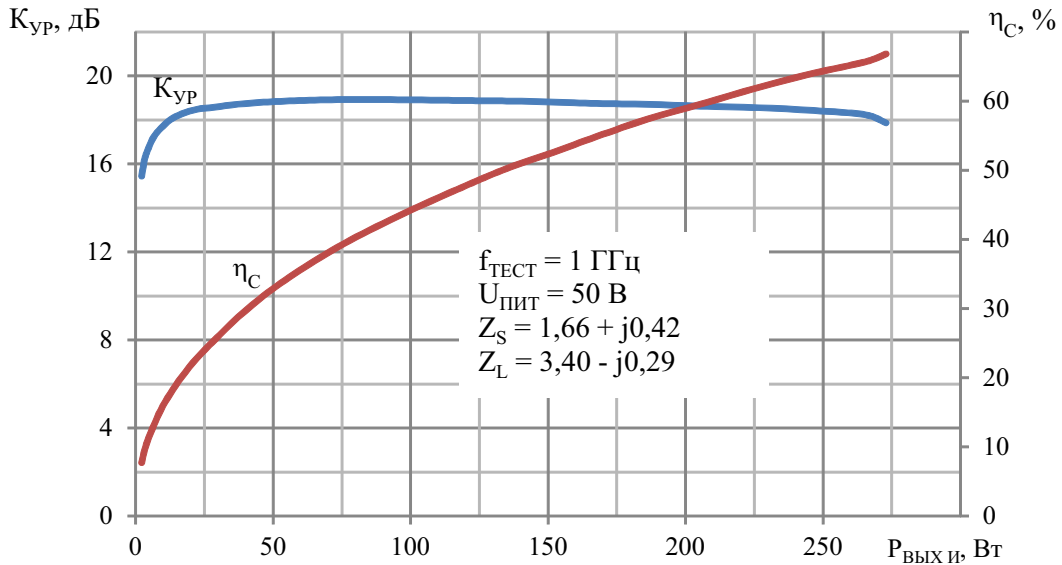


Рисунок 1. Типовая зависимость коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока от выходной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 1 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{C.0.} = 100 \text{ мА}$

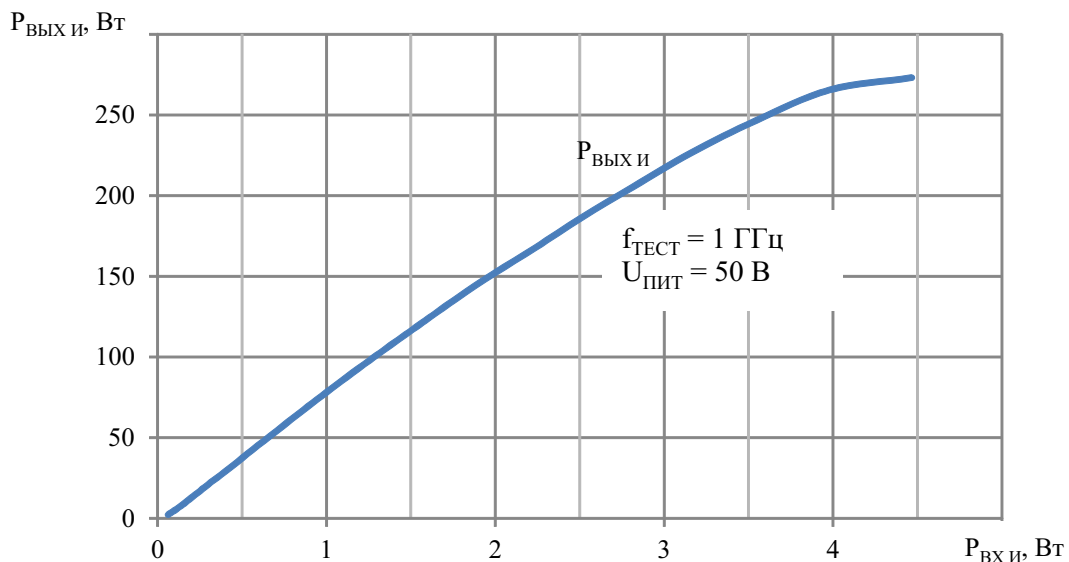


Рисунок 2. Типовая зависимость выходной импульсной мощности от входной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 1 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{C.0.} = 100 \text{ мА}$

Типовые зависимости электрических параметров

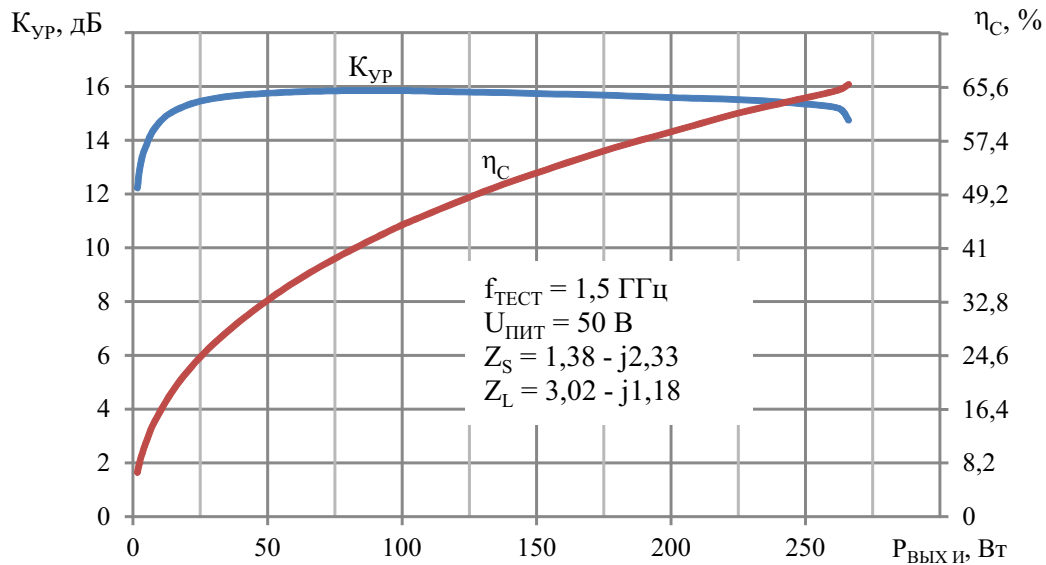


Рисунок 3. Типовая зависимость коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока от выходной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 1,5 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{\text{С.0.}} = 100 \text{ мА}$

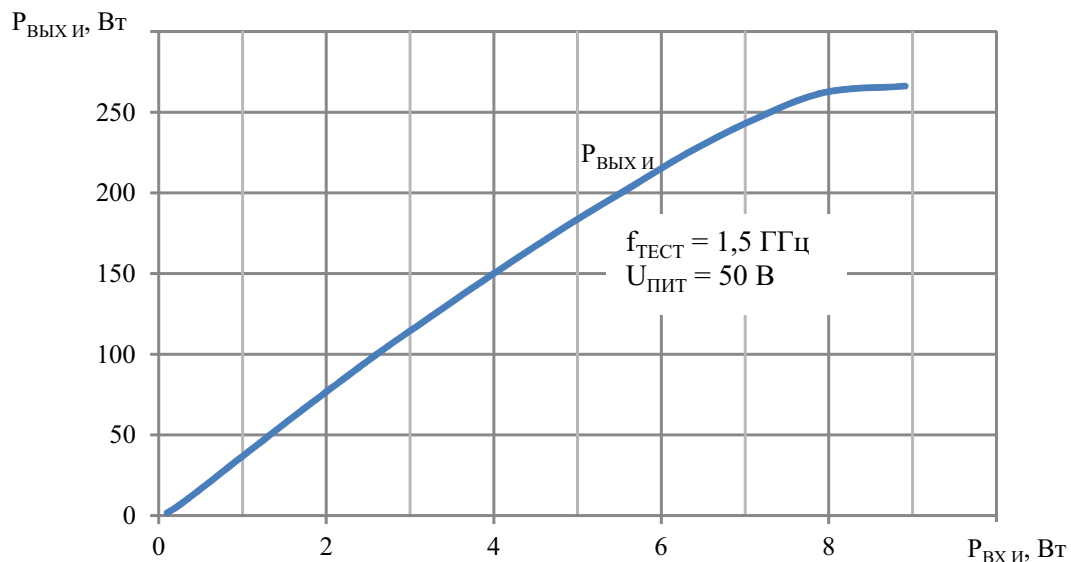


Рисунок 4. Типовая зависимость выходной импульсной мощности от входной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 1,5 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{\text{С.0.}} = 100 \text{ мА}$

Типовые зависимости электрических параметров

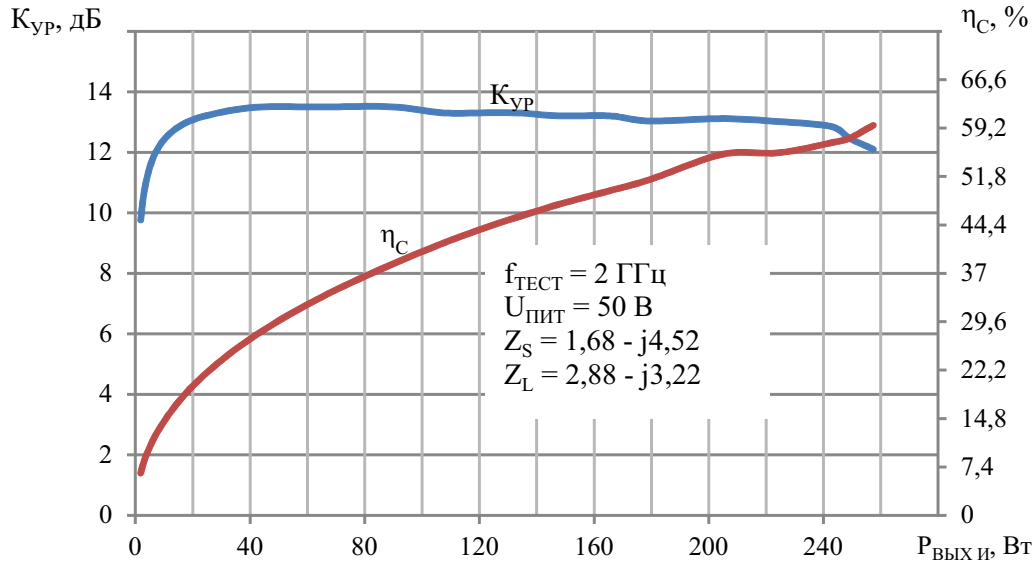


Рисунок 5. Типовая зависимость коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока от выходной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 2 ГГц при $t_{\text{к}} = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{\text{C.0.}} = 100 \text{ мА}$

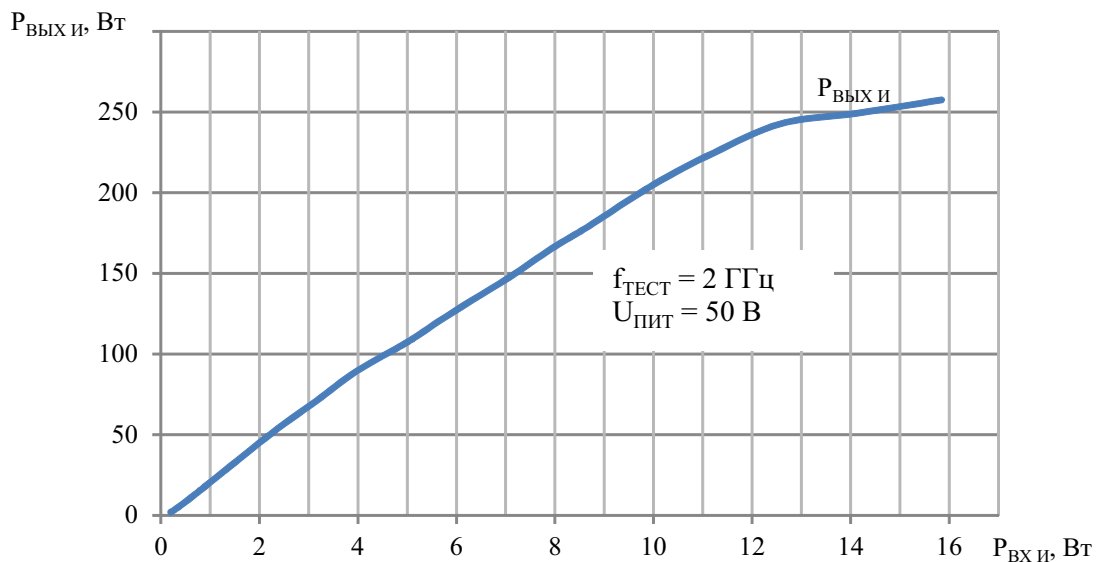


Рисунок 6. Типовая зависимость выходной импульсной мощности от входной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 2 ГГц при $t_{\text{к}} = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{\text{C.0.}} = 100 \text{ мА}$

Типовые зависимости электрических параметров

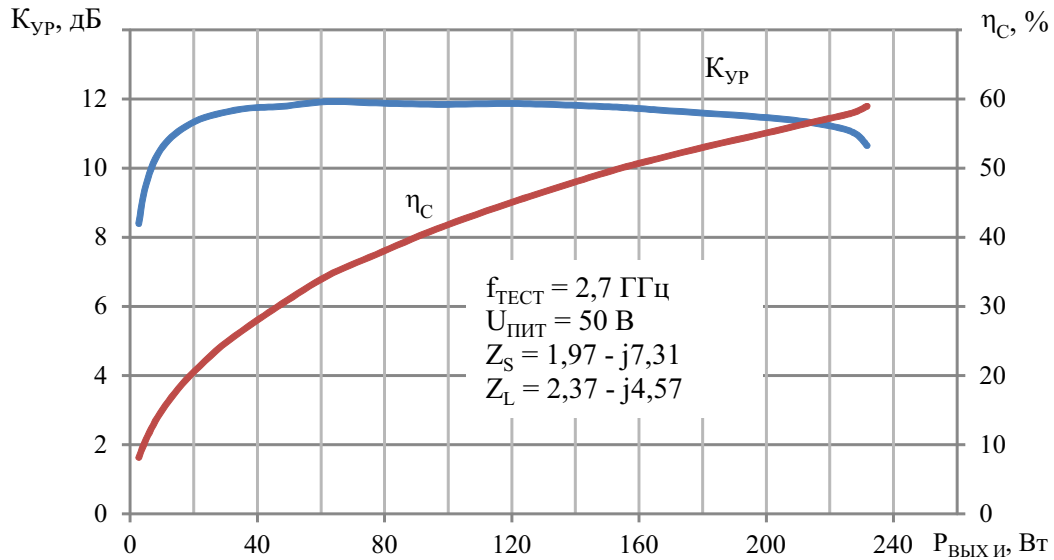


Рисунок 7. Типовая зависимость коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока от выходной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 2,7 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{c.0} = 100 \text{ mA}$

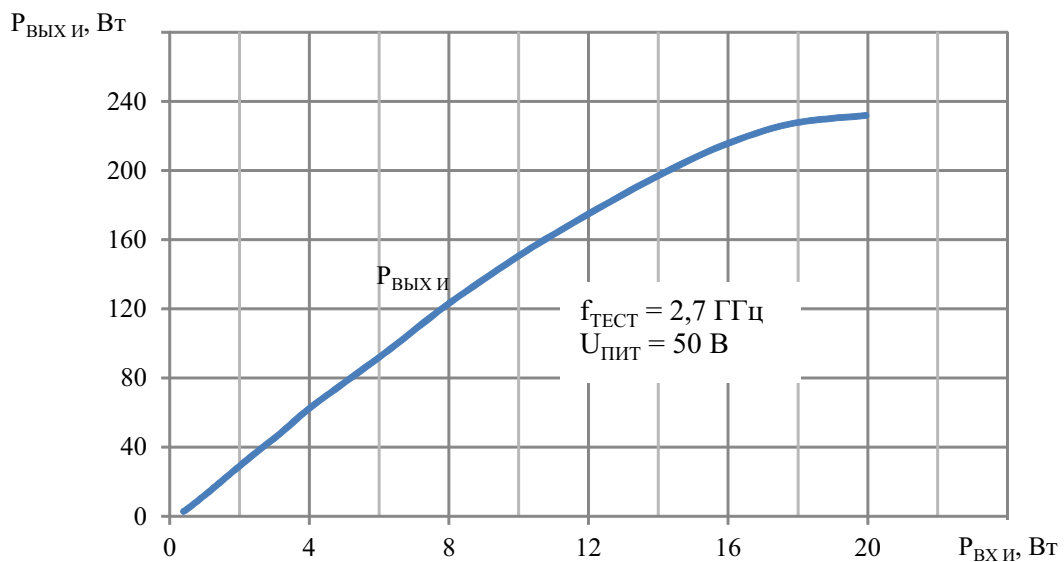


Рисунок 8. Типовая зависимость выходной импульсной мощности от входной импульсной мощности для транзистора ТНГ200200-50 на частоте 2,7 ГГц при $t_k = (25 \pm 15) \text{ }^\circ\text{C}$ и $I_{c.0} = 100 \text{ mA}$

Габаритный чертеж корпуса

